

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 23 年 4 月 21 日 (2011.4.21)

【公開番号】特開 2008-227495 (P2008-227495A)
【公開日】平成 20 年 9 月 25 日 (2008.9.25)
【年通号数】公開・登録公報 2008-038
【出願番号】特願 2008-59321 (P2008-59321)
【国際特許分類】

H 0 1 L 29/861 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/91 L

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 3 月 4 日 (2011.3.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

2 端子半導体整流デバイスであって、

P + + 層と、

該 P + + 層の実質的に下方において該層に隣接して配置された P - ボディと、

該 P - ボディの実質的に下方において該ボディに隣接して配置された N - ドリフト領域と、

該 N - ドリフト領域の実質的に下方に配置された N + 基板と、

前記 P + + 層の実質的に下方において該層に隣接して配置された高次のシリサイド領域と、

前記 N - ドリフト領域、前記 P - ボディ領域、前記 P + + 層、及び、チタンシリサイドの前記領域、のうちの少なくとも 1 つの実質的に上方において該少なくとも 1 つに隣接して配置され、ゲート誘電体として機能する酸化物の層と、

該酸化物の層の実質的に上方において該層に隣接して配置されたポリシリコンの層と、

該ポリシリコンの層の実質的に上方において該層に隣接して配置されたチタンの層と、を具備することを特徴とする半導体整流デバイス。

【請求項 2】

前記チタンが約 300 の厚みを有する、請求項 1 に記載の半導体整流デバイス。

【請求項 3】

前記チタンの層の実質的に上方において該層に隣接して配置された窒化チタンの層をさらに含む、請求項 1 に記載の半導体整流デバイス。

【請求項 4】

前記窒化チタンの層が約 500 の厚みを有する、請求項 3 に記載の半導体整流デバイス。